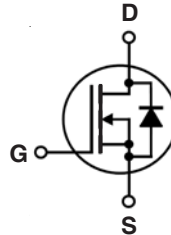


Depletion Mode MOSFET

IXTY1R6N50D2
IXTA1R6N50D2
IXTP1R6N50D2

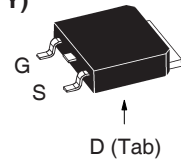
$V_{DSX} = 500V$
 $I_{D(on)} \geq 1.6A$
 $R_{DS(on)} \leq 2.3\Omega$

N-Channel

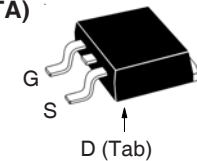


Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{DSX}	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$	500	V
V_{GSX}	Continuous	± 20	V
V_{GSM}	Transient	± 30	V
P_D	$T_C = 25^\circ C$	100	W
T_J		- 55 ... +150	$^\circ C$
T_{JM}		150	$^\circ C$
T_{stg}		- 55 ... +150	$^\circ C$
T_L	Maximum Lead Temperature for Soldering	300	$^\circ C$
T_{SOLD}	1.6 mm (0.062in.) from Case for 10s	260	$^\circ C$
M_d	Mounting Torque (TO-220)	1.13 / 10	Nm/lb.in.
Weight	TO-252	0.35	g
	TO-263	2.50	g
	TO-220	3.00	g

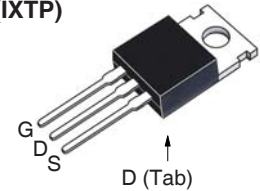
TO-252 (IXTY)



TO-263 (IXTA)



TO-220 (IXTP)



G = Gate D = Drain
S = Source Tab = Drain

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ C$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
BV_{DSX}	$V_{GS} = -5V, I_D = 250\mu A$	500		V
$V_{GS(off)}$	$V_{DS} = 25V, I_D = 100\mu A$	- 2.5		- 4.5 V
I_{GSX}	$V_{GS} = \pm 20V, V_{DS} = 0V$			± 100 nA
$I_{DSX(off)}$	$V_{DS} = V_{DSX}, V_{GS} = -5V$ $T_J = 125^\circ C$			2 μA 25 μA
$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 0V, I_D = 0.8A$, Note 1			2.3 Ω
$I_{D(on)}$	$V_{GS} = 0V, V_{DS} = 25V$, Note 1	1.6		A

Features

- Normally ON Mode
- International Standard Packages
- Molding Epoxies Meet UL94 V-0 Flammability Classification

Advantages

- Easy to Mount
- Space Savings
- High Power Density

Applications

- Audio Amplifiers
- Start-up Circuits
- Protection Circuits
- Ramp Generators
- Current Regulators
- Active Loads

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
g_{fs}	$V_{DS} = 30\text{V}$, $I_D = 0.8\text{A}$, Note 1	1.00	1.75	S
C_{iss}	$V_{GS} = -10\text{V}$, $V_{DS} = 25\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$		645	pF
C_{oss}			65	pF
C_{rss}			16.5	pF
$t_{d(on)}$	Resistive Switching Times $V_{GS} = \pm 5\text{V}$, $V_{DS} = 250\text{V}$, $I_D = 0.8\text{A}$ $R_G = 5\Omega$ (External)		25	ns
t_r			70	ns
$t_{d(off)}$			35	ns
t_f			41	ns
$Q_{g(on)}$	$V_{GS} = 5\text{V}$, $V_{DS} = 250\text{V}$, $I_D = 0.8\text{A}$		23.7	nC
Q_{gs}			2.2	nC
Q_{gd}			13.8	nC
R_{thJC}	TO-220			1.25 $^\circ\text{C/W}$
R_{thCS}			0.50	$^\circ\text{C/W}$

Safe-Operating-Area Specification

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
SOA	$V_{DS} = 400\text{V}$, $I_D = 0.15\text{A}$, $T_C = 75^\circ\text{C}$, $T_p = 5\text{s}$	60		W

Source-Drain Diode

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
V_{SD}	$I_F = 1.6\text{A}$, $V_{GS} = -10\text{V}$, Note 1		0.8	1.3 V
t_{rr}	$I_F = 1.6\text{A}$, $-di/dt = 100\text{A}/\mu\text{s}$ $V_R = 100\text{V}$, $V_{GS} = -10\text{V}$		400	ns
I_{RM}			9.16	A
Q_{RM}			1.83	μC

Note 1. Pulse test, $t \leq 300\mu\text{s}$, duty cycle, $d \leq 2\%$.

IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions, and Dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:

4,835,592	4,931,844	5,049,961	5,237,481	6,162,665	6,404,065 B1	6,683,344	6,727,585	7,005,734 B2	7,157,338B2
4,860,072	5,017,508	5,063,307	5,381,025	6,259,123 B1	6,534,343	6,710,405 B2	6,759,692	7,063,975 B2	
4,881,106	5,034,796	5,187,117	5,486,715	6,306,728 B1	6,583,505	6,710,463	6,771,478 B2	7,071,537	

Fig. 1. Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$

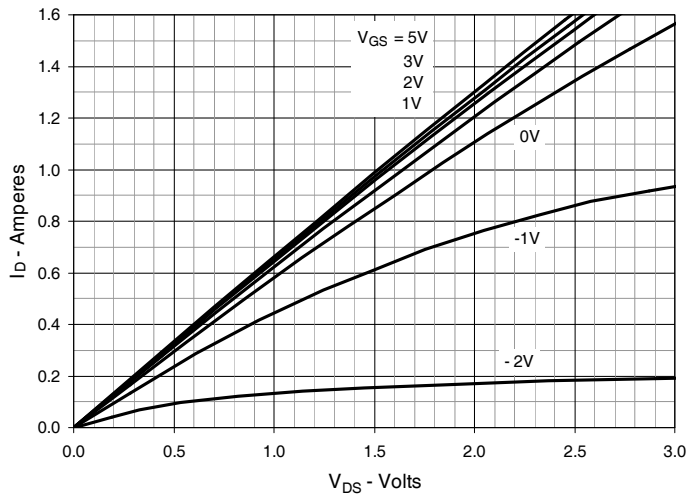


Fig. 2. Extended Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$

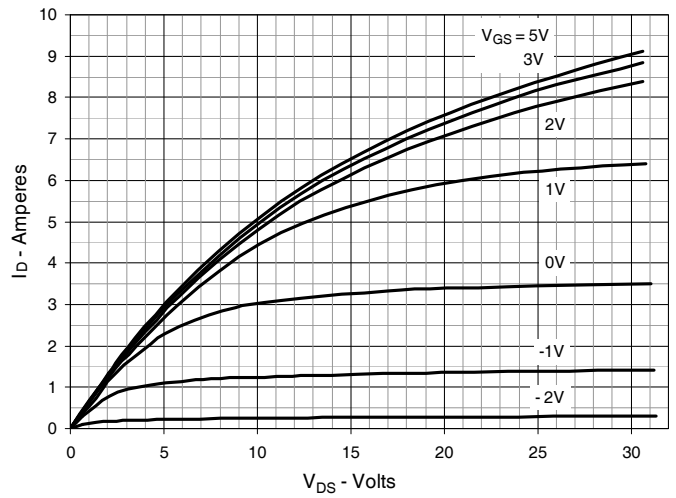


Fig. 3. Output Characteristics @ $T_J = 125^\circ\text{C}$

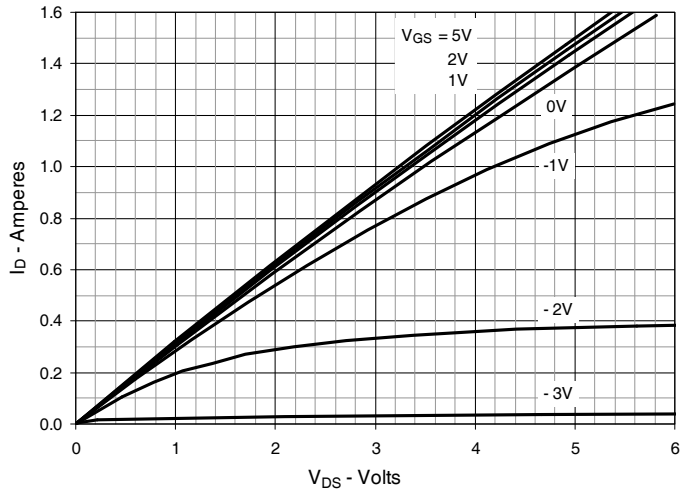


Fig. 4. Drain Current @ $T_J = 25^\circ\text{C}$

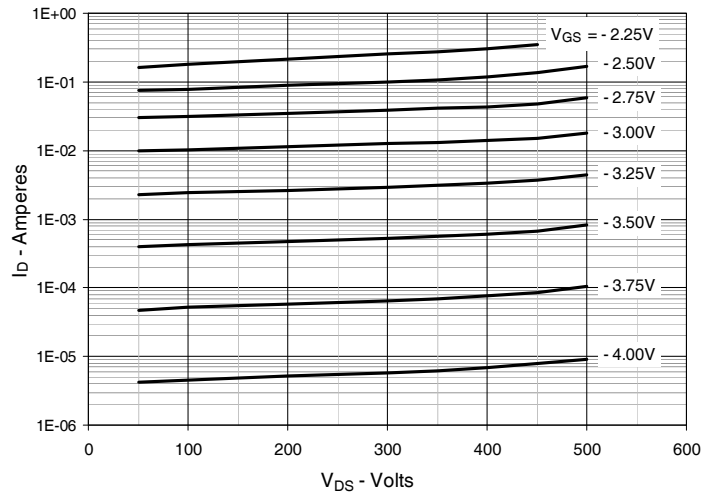


Fig. 5. Drain Current @ $T_J = 100^\circ\text{C}$

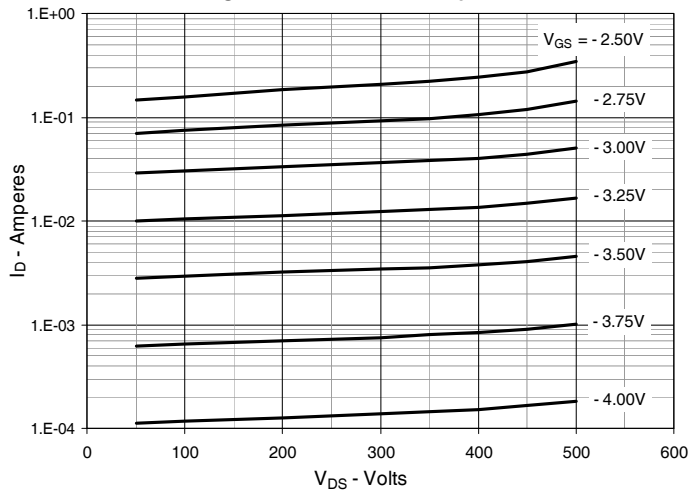


Fig. 6. Dynamic Resistance vs. Gate Voltage

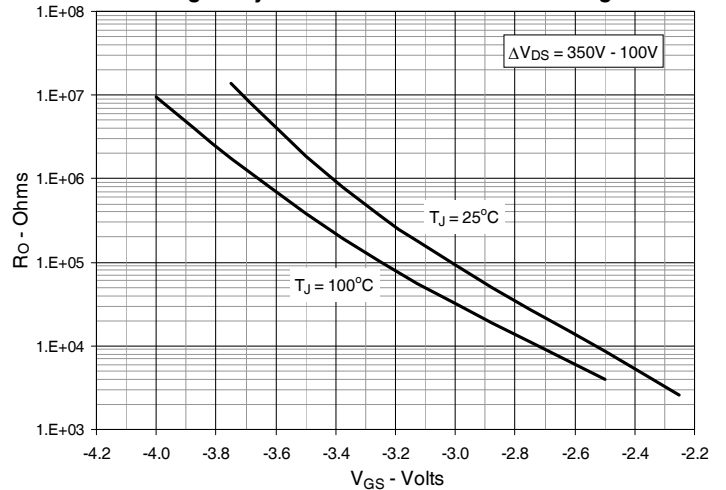


Fig. 7. Normalized $R_{DS(on)}$ vs. Junction Temperature

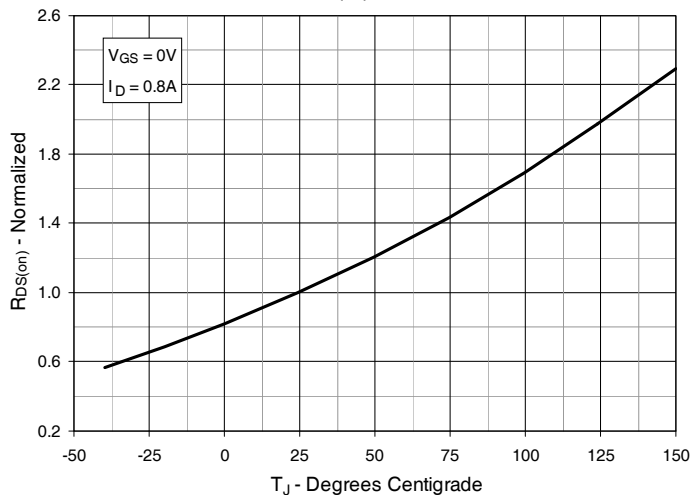


Fig. 8. $R_{DS(on)}$ Normalized to $I_D = 0.8A$ Value vs. Drain Current

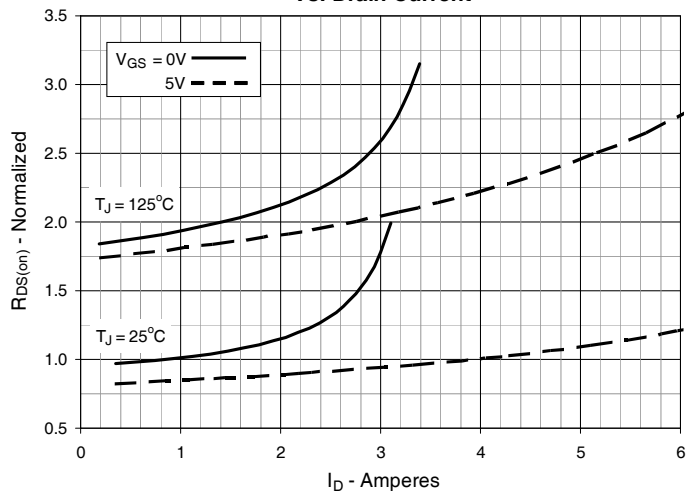


Fig. 9. Input Admittance

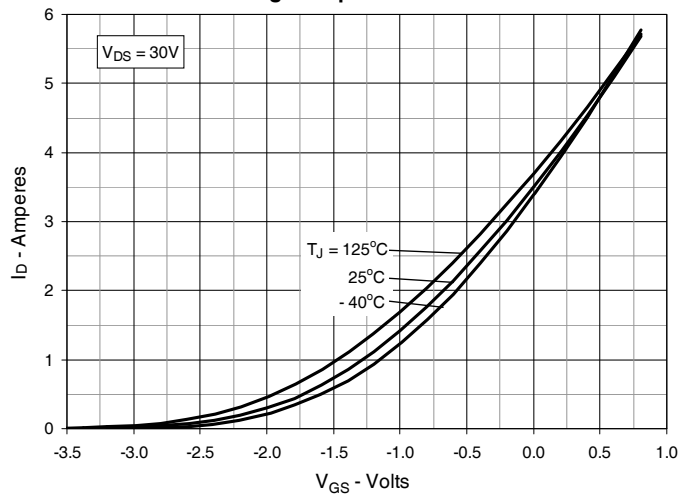


Fig. 10. Transconductance

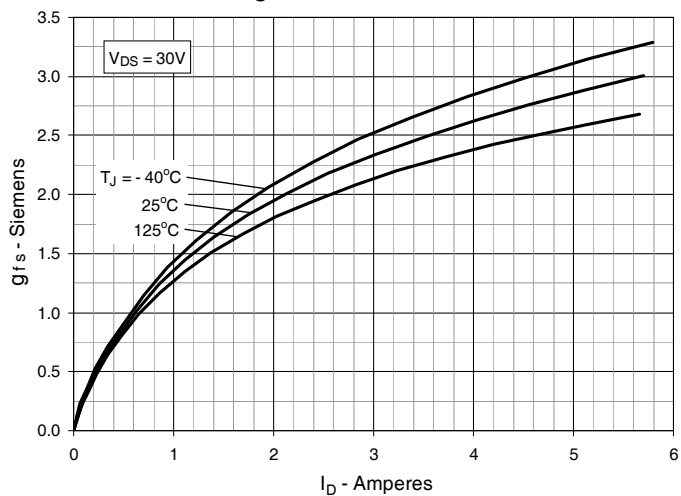


Fig. 11. Breakdown and Threshold Voltages vs. Junction Temperature

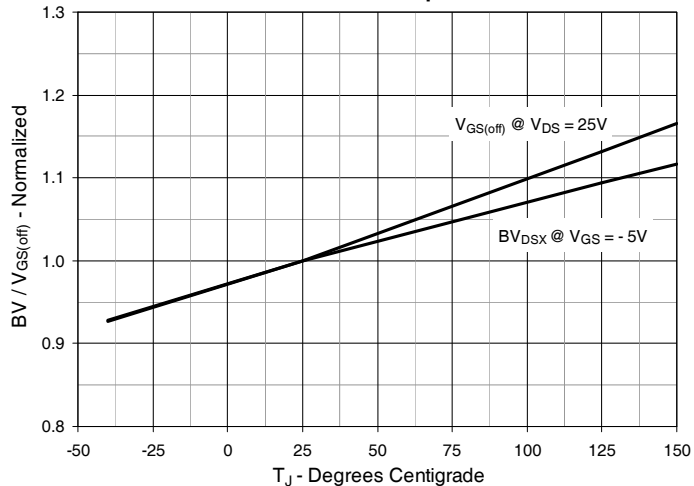


Fig. 12. Forward Voltage Drop of Intrinsic Diode

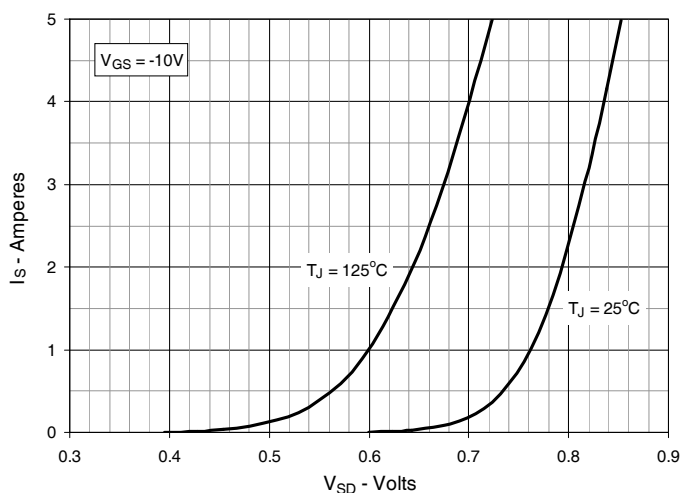


Fig. 13. Capacitance

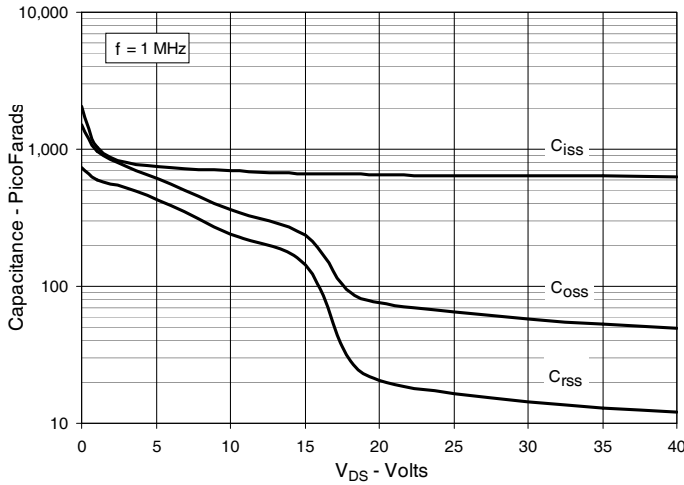


Fig. 14. Gate Charge

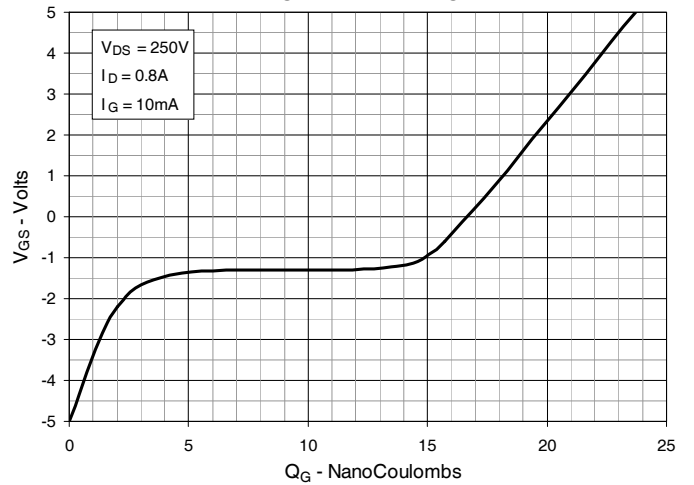


Fig. 15. Forward-Bias Safe Operating Area
@ $T_C = 25^\circ\text{C}$

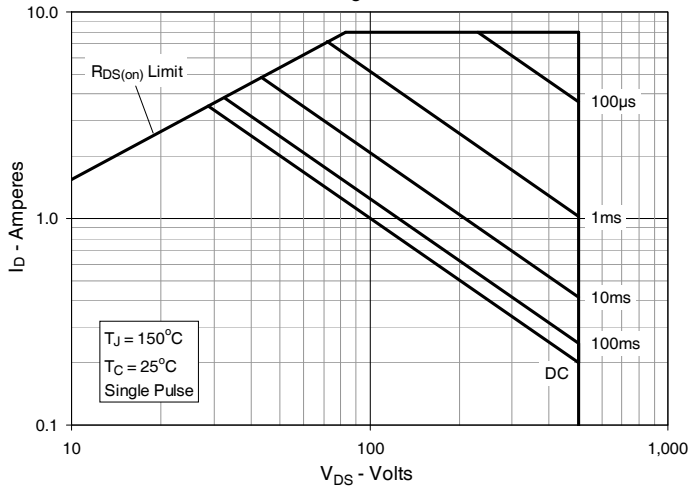


Fig. 16. Forward-Bias Safe Operating Area
@ $T_C = 75^\circ\text{C}$

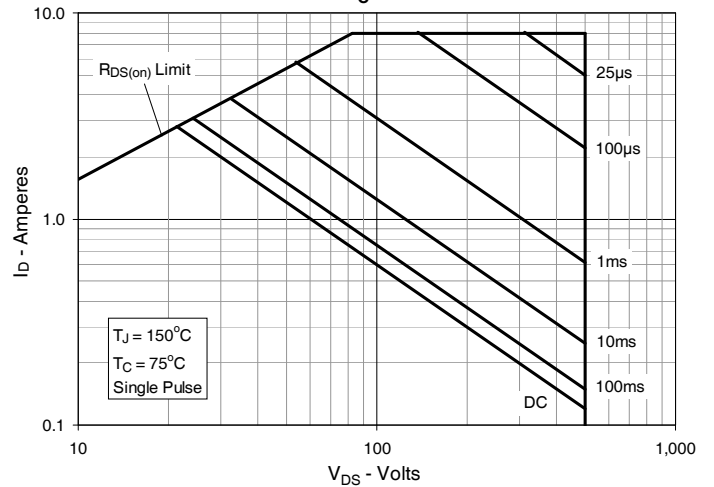
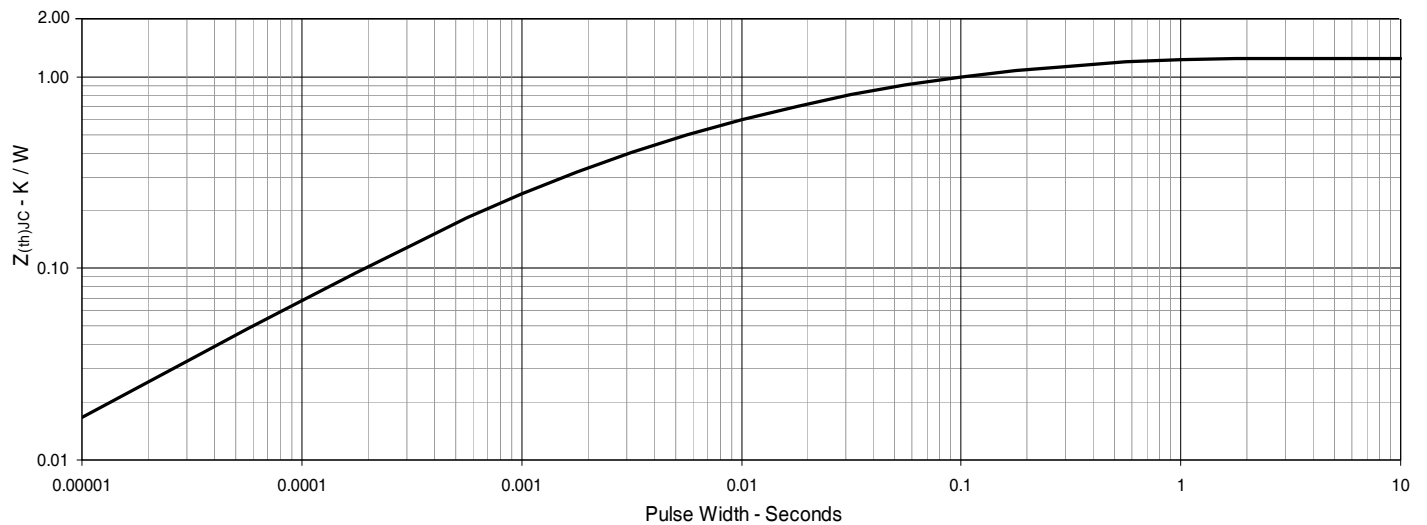


Fig. 17. Maximum Transient Thermal Resistance





Disclaimer Notice - Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А